

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-203385
 (43)Date of publication of application : 27.07.2001

(51)Int.Cl. H01L 33/00

(21)Application number : 2000-010346
 (22)Date of filing : 17.01.2000

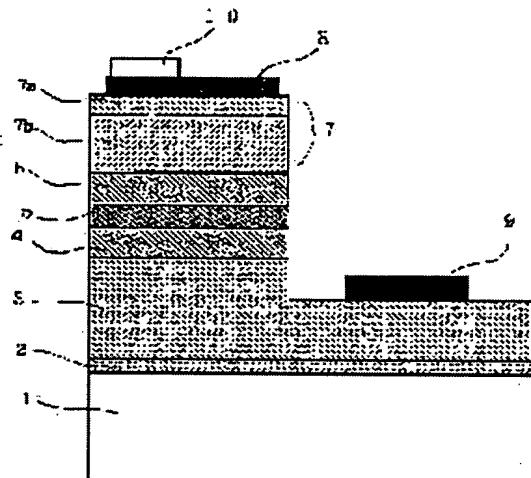
(71)Applicant : NICHIA CHEM IND LTD
 (72)Inventor : MORITA DAISUKE

(54) NITRIDE SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DIODE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a nitride semiconductor light emitting diode having an emission peak wavelength of 370 nm or below in which a good ohmic contact can be obtained and emission output can be enhanced by suppressing self absorption.

SOLUTION: An active layer comprises a nitride semiconductor layer having an emission peak wavelength of 370 nm or below. A p-type contact layer comprises a first p-type contact layer containing $\text{Al}_a\text{Ga}_{1-a}\text{N}$ ($0 \leq a < 0.05$) heavily doped with a p-type impurity on the side touching the p electrode, and a second p-type contact layer touching the first p-type contact layer on the active layer side thereof and containing $\text{Al}_b\text{Ga}_{1-b}\text{N}$ ($0 < b < 0.1$) having Al compositional ratio higher than in the first p-type contact layer and doped with a p-type impurity at a lower concentration than in the first p-type contact layer. Further, an n-type contact layer touching an n electrode contains $\text{Al}_d\text{Ga}_{1-d}\text{N}$ ($0 < d < 0.1$).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 15.04.2002
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number] 3614070
 [Date of registration] 12.11.2004
 [Number of appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
 [Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and NCIP1 are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] In the nitride semiconductor device which has n mold nitride semi-conductor layer, a barrier layer, and p mold nitride semi-conductor layer at least on a substrate An emission peak wavelength consists [said barrier layer] of a nitride semi-conductor layer 370nm or less. As said p mold nitride semi-conductor layer 1st p mold contact layer to which p mold contact layer which touches p electrode comes to contain Al_aGa_{1-a}N ($0 <= a < 0.05$) which contains p mold impurity by high concentration in the side which touches p electrode, 1st p mold contact layer is touched at the barrier layer side of said 1st p mold contact layer. It comes to be formed from 2nd p mold contact layer which contains p mold impurity by low concentration from 1st p mold contact layer, and comes to contain Al_bGa_{1-b}N ($0 < b < 0.1$) with aluminum presentation ratio still higher than 1st p mold contact layer. Furthermore, nitride semi-conductor light emitting diode with which n mold contact layer which touches n electrode is characterized by coming to contain Al_dGa_{1-d}N ($0 < d < 0.1$) as said n mold nitride semi-conductor layer.

[Claim 2] Nitride semi-conductor light emitting diode according to claim 1 with which 1st p mold contact layer which touches said p electrode is characterized by coming to contain p mold impurity 1×10^{19} to $1 \times 10^{22}/\text{cm}^3$.

[Claim 3] Nitride semi-conductor light emitting diode according to claim 1 or 2 with which said 2nd p mold contact layer is characterized by coming to contain p mold impurity three or less $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$.

[Claim 4] Nitride semi-conductor light emitting diode according to claim 1 which the thickness of 1st p mold contact layer in said p mold contact layer is 100–500Å, and is further characterized by the thickness of 2nd p mold contact layer being 400–2000Å.

[Claim 5] Nitride semi-conductor light emitting diode according to claim 4 with which said n mold contact layer is characterized by coming to contain n mold impurity 1×10^{17} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$.

[Claim 6] Nitride semi-conductor light emitting diode according to claim 1 characterized by having the 1st nitride semi-conductor layer which comes to contain Al_eGa_{1-e}N ($0 < e < 0.3$) between said barrier layer and n mold contact layer, and having further the 2nd nitride semi-conductor layer which comes to contain Al_fGa_{1-f}N ($0 < f < 0.4$) between said barrier layer and p mold contact layer.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIP are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the nitride semi-conductor light emitting diode with which an emission peak wavelength emits light to an ultraviolet region 370nm or less especially about the nitride semiconductor device ($InXAlYGa1-X-YN$, $0 \leq X, 0 \leq Y$, $X+Y \leq 1$) used for light emitting devices, such as light emitting diode (LED), a laser diode (LD), a solar battery, and a photosensor, and a photo detector.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, ultraviolet [LED] is usable. For example, the nitride semiconductor device which comes to carry out the laminating of a GaN buffer layer, an n mold GaN contact layer (thickness: 4 micrometers), an n mold AlGaN cladding layer, the barrier layer (for most In presentations to be zero) of Undoping InGaN, a p mold AlGaN cladding layer, and the p mold GaN contact layer (thickness: 0.12 micrometers) on silicon on sapphire is indicated by application physics, the 68th volume, No. 2 (1999), and p152-p155. And since n mold and p mold contact layer are GaN(s) when, as for ultraviolet [this / LED], luminescence wavelength is made into short wavelength from this to a radiant power output being 5mW when a luminescence peak is 371nm under fixed conditions, a self-absorption starts, and it is indicated that a radiant power output becomes low rapidly. Furthermore, in order to prevent the fall of this radiant power output and to enable short wavelengthization of oscillation wavelength, it is suggested that a self-absorption can be prevented by setting n mold and p mold contact layer to AlGaN.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, if a contact layer is only grown up into extent which can fully prevent a self-absorption by high AlGaN of aluminum presentation ratio, the good ohmic contact to an electrode will become hard to be acquired. It is thought that as for this cause the good ohmic contact to an electrode will become hard to be acquired since AlGaN causes inactivation of a dopant in physical properties or fluctuation probably arises to the difference of a work function with the metal which serves as an electrode by fluctuation of Fermi level. The fall of such ohmic contact is large in p mold contact layer. Moreover, if many impurities are doped in a contact layer in order to improve the point as for which ohmic contact becomes inactivation of a dopant arises by including aluminum presentation as mentioned above, and is hard to be acquired, since impurity level will be formed in proportion [almost] to the amount of an impurity, a self-absorption may become large on the contrary, and a radiant power output may decline by crystalline fall etc.

[0004] Furthermore, although reducing a self-absorption relatively is also considered by making thickness thin by setting a contact layer to GaN, when thickness of p mold contact layer is made thin, for example, a component property becomes less enough, and if thickness of n mold contact layer is made thin, it will become difficult further to make it expose, while actuation becomes complicated, in case n mold contact layer is exposed.

[0005] Thus, although a self-absorption will arise [the emission peak wavelength in the conventional technique] in a contact layer in light emitting diode 370nm or less and a radiant power output will decline, if the amount of dopes of an impurity is made to increase in order for the fall of ohmic contact to arise and to acquire ohmic contact further, if a contact layer is only grown up as AlGaN in order to prevent the self-absorption by GaN, a self-absorption will arise by formation of impurity level, or the increment in a crystal defect. Therefore, to make ohmic contact good with prevention of a self-absorption is desired.

[0006] Then, the purpose of this invention is that control a self-absorption and the emission peak wavelength which a radiant power output can improve offers nitride semi-conductor light emitting diode 370nm or less while good ohmic contact is acquired.

[0007]

[Means for Solving the Problem] That is, this invention can attain the purpose of this invention by the configuration of following the (1) - (6).

- (1) In the nitride semiconductor device which has n mold nitride semi-conductor layer, a barrier layer, and p mold nitride semi-conductor layer at least on a substrate An emission peak wavelength consists [said barrier layer] of a nitride semi-conductor layer 370nm or less. As said p mold nitride semi-conductor layer 1st p mold contact layer to which p mold contact layer which touches p electrode comes to contain $Al_xGa_{1-x}N$ ($0 < x < 0.05$) which contains p mold impurity by high concentration in the side which touches p electrode, 1st p mold contact layer is touched at the barrier layer side of said 1st p mold contact layer. It comes to be formed from 2nd p mold contact layer which contains p mold impurity by low concentration from 1st p mold contact layer, and comes to contain $Al_bGa_{1-b}N$ ($0 < b < 0.1$) with aluminum presentation ratio still higher than 1st p mold contact layer. Furthermore, nitride semi-conductor light emitting diode with which n mold contact layer which touches n electrode is characterized by coming to contain $Al_dGa_{1-d}N$ ($0 < d < 0.1$) as said n mold nitride semi-conductor layer.
- (2) Nitride semi-conductor light emitting diode given in the above (1) whose 1st p mold contact layer which touches p electrode is characterized by coming to contain p mold impurity 1×10^{19} to $1 \times 10^{22}/cm^3$.
- (3) The above (1) said whose 2nd p mold contact layer is characterized by coming to contain p mold impurity three or less $1 \times 10^{20}/cm$, or nitride semi-conductor light emitting diode given in (2).
- (4) Nitride semi-conductor light emitting diode given in the above (1) characterized by for the thickness of 1st p mold contact layer in said p mold contact layer being 100-500A, and the thickness of 2nd p mold contact layer being 400-2000A further.
- (5) Nitride semi-conductor light emitting diode given in the above (4) said whose n mold contact layer is characterized by coming to contain n mold impurity 1×10^{17} to $1 \times 10^{19}/cm^3$.
- (6) Nitride semi-conductor light emitting diode given in the above (1) characterized by having the 1st nitride semi-conductor layer which comes to contain $Al_eGa_{1-e}N$ ($0 < e < 0.3$) between said barrier layer and n mold contact layer, and having further the 2nd nitride semi-

conductor layer which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.4$) between said barrier layer and p mold contact layer.

[0008] This invention sets n mold contact layer to AlGaN which consists of a specific aluminum presentation ratio. Further p mold contact layer That is, 1st small p mold contact layer of aluminum presentation ratio with high p mold high impurity concentration, By p mold high impurity concentration forming from 2nd low p mold contact layer with high aluminum presentation ratio, and coming to form the 1st contact layer with high p mold high impurity concentration in the side which touches p electrode While good ohmic contact is acquired, a self-absorption can be controlled, and the good emission peak wavelength of a radiant power output can obtain nitride semiconductor light emitting diode 370nm or less. The relative relation in 1st p mold contact layer and 2nd p mold contact layer which constitute p mold contact layer here in this invention low [p mold high impurity concentration in p mold contact layer is high, or] as aluminum presentation ratio is high or it is low is shown.

[0009] If this invention person includes aluminum presentation only for prevention of a self-absorption as described above The result which was attached to the point referred to as causing the fall of ohmic contact, and was variously examined by inactivation of an impurity etc., It considered setting n mold contact layer to AlGaN of specific aluminum presentation ratio, and making thickness into two-layer structure with the layer of a secured *** sake, in order to maintain the layer and component property for acquiring ohmic contact for p mold contact layer further. And 1st p mold contact layer to which this invention person touches low p electrode of aluminum presentation ratio with high p mold impure concentration as mentioned above, By combining with n mold contact layer which forms p mold contact layer in 2nd p mold contact layer with high aluminum presentation ratio with low high impurity concentration, and consists of a further specific aluminum presentation ratio Prevention of a self-absorption of ohmic contact was attained good, and it attained obtaining the good nitride semi-conductor light emitting diode of a radiant power output.

[0010] Furthermore, in this invention, 1st p mold contact layer is desirable in p mold impurity, at 1×10^{19} to $1 \times 10^{22}/\text{cm}^3$, and the point of acquiring good ohmic contact, when it comes to contain 5×10^{20} to $5 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ preferably. Furthermore, in this invention, when it comes to contain p mold impurity 5×10^{18} to $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ preferably three or less $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$, in order to maintain a component property, even if 2nd p mold contact layer thickens thickness of p mold contact layer, it is desirable at the point that a self-absorption can be prevented.

[0011] Furthermore, in this invention, 100–500A, if the thickness of 1st p mold contact layer in p mold contact layer is 150–300A preferably If thickness is thinly set up even if it makes p mold high impurity concentration high, while being able to perform the self-absorption by impurity level small relatively Ohmic contact to p electrode can be made good, and 400–2000A, while the thickness of 2nd p mold contact layer can prevent a self-absorption as it is 800–1200A preferably, although a component property is maintained, it is still more desirable.

[0012] furthermore, n mold contact layer in which this invention comes to contain aluminum — n mold high impurity concentration — 1×10^{17} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ — desirable — 1×10^{18} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ — being certain — ** — it is desirable at the point which maintains ohmic contact and raises a radiant power output with prevention of a self-absorption. Thus, when aluminum presentation ratio and n mold high impurity concentration of n mold contact layer are specified and combined, it is desirable like the case of p mold contact layer in respect of improvement in ohmic contact and crack prevention, and a radiant power output.

[0013] This invention has the 1st nitride semi-conductor layer which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.3$) between said barrier layer and n mold contact layer. Further furthermore, between said barrier layer and p mold contact layer When it has the 2nd nitride semi-conductor layer which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.4$), the carrier to a barrier layer closes, eye ** can be made good, and it is desirable in respect of the improvement in a radiant power output. Furthermore, when each aluminum presentation ratio of the 1st nitride semi-conductor layer and the 2nd nitride semi-conductor layer is made into the above-mentioned range and aforementioned aluminum presentation ratio and the high impurity concentration of a contact layer are combined, prevention of crack initiation and ohmic contact can be made good, and it is desirable in respect of improvement in a radiant power output. Since said 1st nitride semi-conductor layer and the 2nd nitride semi-conductor layer have a function as a cladding layer, they make n mold cladding layer and the 2nd nitride semi-conductor layer p mold cladding layer for the 1st nitride semi-conductor layer hereafter in this invention. However, it is not limited to this.

[0014]

[Embodiment of the Invention] Drawing 1 is used for below and this invention is further explained to it at a detail. Drawing 1 is the typical sectional view of the nitride semiconductor device which is the gestalt of 1 operation of this invention. In drawing 1, on a substrate 1 A buffer layer 2 and Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.1$) n mold contact layer 3, Al_xGa_{1-x}N which it comes to contain n mold cladding layer 4 which comes to contain ($0 < x < 0.3$), the barrier layer 5 of In_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.1$), p mold cladding layer 6 which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.4$), and 2nd p mold contact layer 7b which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.1$), It comes to carry out laminating growth of the p mold contact layer 7 which consists of the 1st p mold contact layer 7a which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.05$), and the nitride semiconductor device 370nm or less is indicated for the emission peak wavelength. And in contact with 1st p mold contact layer 7a of p mold contact layer 7, p electrode is formed in n mold contact layer 3 for n electrode, respectively. First, n mold contact layer 3 of this invention and p mold contact layer 7 are indicated.

[0015] In [n mold contact layer 3] this invention, it is the nitride semi-conductor layer which comes to contain Al_xGa_{1-x}N ($0 < x < 0.1$, preferably $0.01 < x < 0.05$) at least as an n mold contact layer 3. It is desirable in respect of the crystallinity and ohmic contact by prevention of a self-absorption. [be / aluminum presentation ratio / the above-mentioned range] furthermore, said n mold contact layer 3 — n mold impurity — 1×10^{17} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ — when preferably contained by the concentration of 1×10^{18} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$, it is desirable in respect of maintenance of ohmic contact, prevention of crack initiation, and crystalline maintenance. Thus, if aluminum presentation ratio and n mold high impurity concentration which constitute n mold contact layer are combined, while being able to prevent a self-absorption, it is desirable in respect of ohmic contact or crack prevention. Especially as an n mold impurity, although not limited, Si, germanium, etc. are mentioned and it is Si preferably, for example. Although especially the thickness of n mold contact layer 3 is not limited, its 0.1–20 micrometers are desirable, and it is 1–10 micrometers more preferably. It is desirable in respect of decline in the crystallinity (as a substrate) near an interface (for example, near an interface with n mold cladding layer), and resistivity by thickness being this range.

[0016] In [p mold contact layer 7] this invention, it is formed as a p mold contact layer 7 from p mold contact layer 7 with high p mold high impurity concentration which touches p electrode at least of ** low 1st of aluminum presentation ratio a, and 2nd high p mold contact layer 7b of aluminum presentation ratio with low p mold high impurity concentration. Thus, by forming p mold contact layer 7 in two kinds of layers from which p mold high impurity concentration and aluminum presentation ratio differ Good ohmic contact can be acquired by 1st p mold contact layer 7a, and even when p mold contact layer is adjusted to the thickness of extent which can maintain a component property further and thickness of 2nd p mold contact layer 7b is thickened, since aluminum presentation ratio is high, a self-absorption can be prevented. That is, in p mold contact layer 7, it becomes extent which can maintain a component property from two-layer [with 2nd p mold contact layer 7b for securing thickness], preventing 1st p mold contact layer 7a for acquiring ohmic

contact, and a self-absorption. 1st p mold contact layer 7a and 2nd p mold contact layer 7b are explained below. 1st p mold contact layer 7a has high high impurity concentration compared with 2nd p mold contact layer 7b, and aluminum presentation ratio is set up low. [0017] As such 1st p mold contact layer 7a, the nitride semi-conductor layer which comes to contain AlGa1-aN ($0 \leq a < 0.05$, preferably $0 < a < 0.01$) can be mentioned. Even if it dopes p mold high impurity concentration to high concentration as aluminum presentation ratio is the above-mentioned range, inactivation of an impurity can be prevented, the good ohmic contact to p electrode can be acquired, and it is desirable. Moreover, when 1st p mold contact layer 7a comes to contain aluminum presentation within the limits of the above, it is desirable in respect of prevention of a self-absorption, and desirable also in respect of further crystallinity. Moreover, aluminum presentation ratio of 1st p mold contact layer 7a is [above-mentioned] within the limits, and it is adjusted so that it may become low from aluminum presentation ratio of 2nd p mold contact layer 7b.

[0018] extent from which the ohmic contact to p electrode is acquired good especially as p mold high impurity concentration of 1st p mold contact layer 7a although not limited — desirable — for example, — concrete — 1×10^{19} to $1 \times 10^{22}/\text{cm}^3$ — it is 5×10^{20} to $5 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ preferably. p mold high impurity concentration can acquire ohmic contact good as it is the above-mentioned range, and it is desirable. p mold high impurity concentration of 1st p mold contact layer 7a is above-mentioned within the limits, and it is adjusted so that it may become higher than the high impurity concentration of 2nd p mold contact layer 7b. Moreover, especially as thickness of 1st p mold contact layer 7a, although not limited, specifically, 100 – 500A is 150 – 300A preferably that what is necessary is just the thickness of extent from which the ohmic contact to p electrode becomes good. It is desirable at the point of being able to prevent a self-absorption since thickness is comparatively thin even if it carries out aluminum presentation ratio to it being such thickness low, containing p mold impurity in high concentration further, and acquiring good ohmic contact.

[0019] Next, as 2nd p mold contact layer 7b, it is the nitride semi-conductor layer which comes to contain AlGa1-bN ($0 < b < 0.1$, preferably $0.01 < b < 0.05$). It is desirable in respect of prevention of a self-absorption like the case where it is n mold contact layer as aluminum presentation ratio is the above-mentioned range, and still more desirable also in respect of crystallinity and ohmic contact. Moreover, aluminum presentation ratio of 2nd p mold contact layer 7b is above-mentioned within the limits, and it is adjusted so that it may become high from 1st p mold contact layer 7a. It is 5×10^{18} to $5 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ preferably that 2nd p mold contact layer 7b contains p mold high impurity concentration of 2nd p mold contact layer 7b in extent which shows p mold three or less $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ desirably, for example, specifically. p mold high impurity concentration is desirable in respect of prevention of the self-absorption according that it is the above-mentioned range to formation of impurity level. p mold high impurity concentration of 2nd p mold contact layer 7b is above-mentioned within the limits, and is adjusted to low concentration from 1st p mold contact layer 7a.

[0020] Especially as thickness of 2nd p mold contact layer 7b, although not limited, 2nd 400 – 1200A p mold contact layer 7b is 800 – 1200A preferably. It is desirable at the point which can be adjusted to the thickness of extent which can maintain a component property, preventing a self-absorption as the thickness of 2nd p mold contact layer 7b is the above-mentioned range. Especially as a p mold impurity contained in p mold contact layer 7, although not limited, Mg is mentioned preferably, for example.

[0021] Moreover, although 1st p mold contact layer 7a and 2nd p mold contact layer 7b which constitute p mold contact layer 7 have the part which high impurity concentration and aluminum presentation ratio overlap here as shown above Good effectiveness can be acquired by being adjusted so that 1st p mold contact layer 7a may have high high impurity concentration to 2nd p mold contact layer 7b and aluminum presentation ratio may become low in the range indicated, respectively. Temporarily, if p mold contact layer 7 is formed in a layer with high low layer of aluminum presentation ratio or high impurity concentration etc., even if ohmic contact is good, it will become that it can be hard to obtain both of prevention of a self-absorption with the good ohmic contact of prevention of a self-absorption being unsatisfying enough etc. Moreover, it constitutes so that prevention of ohmic contact and a self-absorption may be obtained by each layer, as it said that maintenance of a component property could do p mold contact layer 7 while good ohmic contact is acquired by 1st small p mold contact layer 7a of aluminum presentation ratio with high p mold high impurity concentration and it prevents a self-absorption by p mold contact layer 7 with low p mold high impurity concentration of ** 2nd with large aluminum presentation ratio b. And the layer of 1st p mold contact layer 7a and 2nd p mold contact layer 7b can act in multiplication, and the good component of a radiant power output can be obtained by prevention of good ohmic contact and a good self-absorption. Moreover, with the present nitride semi-conductor, p mold formation is difficult and prevention of the self-absorption by the side of the good ohmic contact especially by the side of p and p is more important than n mold by p side-face luminescence on a component structure target.

[0022] Furthermore, the thing for which aluminum presentation ratio of n mold contact layer 3 is specified as mentioned above, specifying high impurity concentration preferably in addition to aluminum presentation ratio — in addition p mold contact layer 7 is formed by 1st p mold contact layer 7a with low aluminum presentation ratio with high p mold high impurity concentration, and 2nd high p mold contact layer 7b of aluminum presentation ratio with low p mold high impurity concentration. A self-absorption can be prevented more to fitness, without causing ***** and the fall of ohmic contact, and it is more desirable in respect of improvement in a radiant power output.

[0023] Furthermore, each class of others which constitute a component is explained below.

In [substrate 1] this invention, semi-conductor substrates, such as SiC (6H, 4H, and 3C are included), Si and ZnO besides the sapphire which makes a principal plane a sapphire C side, the Rth page, or the Ath page, and other insulating substrates like a spinel (MgAl₂O₄), GaAs, and GaN, can be used as a substrate 1.

[0024] In [buffer layer 2] this invention, as a buffer layer 2, it is the nitride semi-conductor which consists of GaAl_{1-h}N (however, the range of h is $0 < h \leq 1$), and the buffer layer 2 which it becomes more remarkable [the presentation with the rate of aluminum it is desirable and smaller] crystalline improving, and consists of GaN more preferably is mentioned. 0.002–0.5 micrometers of 0.005–0.2 micrometers of thickness of a buffer layer 2 are preferably adjusted to the range of 0.01–0.02 micrometers still more preferably. The crystal morphology of a nitride semi-conductor becomes good for the thickness of a buffer layer 2 to be the above-mentioned range, and the crystallinity of the nitride semi-conductor grown up on a buffer layer 2 is improved. The growth temperature of a buffer layer 2 is 200–900 degrees C, and is preferably adjusted to the range of 400–800 degrees C. Growth temperature serves as good polycrystal with it being the above-mentioned range, and this polycrystal makes good the crystallinity of the nitride semi-conductor grown up on a buffer layer 2 as seed crystal and is desirable. Moreover, the buffer layer 2 grown up at such low temperature may be omitted by the class of substrate, the growth approach, etc.

[0025] [n mold contact layer 3] It is the nitride semi-conductor which comes to contain AlGaN of the above-mentioned n mold impurity content.

[0026] In [n mold cladding layer 4] this invention, although it is the presentation which becomes larger than the bandgap energy of a barrier layer 5, the carrier to a barrier layer 5 closes, and it will not be limited as an n mold cladding layer 4 especially if eye ** is possible, as a desirable presentation, the thing of AlGa1-eN ($0 < e < 0.3$, preferably $0.1 < e < 0.2$) is mentioned. When n mold cladding layer consists of such AlGaN, it is desirable at the point which the carrier to a barrier layer shuts up. Although especially the thickness of n

mold cladding layer is not limited, it is 0.01–0.1 micrometers preferably, and is 0.03–0.06 micrometers more preferably. Although especially n mold high impurity concentration of n mold cladding layer is not limited, it is 1×10^{17} to $1 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ preferably, and is 1×10^{18} to $1 \times 10^{19}/\text{cm}^3$ more preferably. High impurity concentration is desirable resistivity and in respect of crystallinity in it being this range.

[0027] n mold cladding layer can also be used as the multilayers layer (a superstructure is included) other than the above monolayers. In the case of a multilayers layer, it should just be the multilayers layer which consists of above Al_xGa_{1-x}N and a nitride semi-conductor layer with bandgap energy smaller than it, but, for example as a small layer of bandgap energy, In_kGa_{1-k}N ($0 < k < 1$) and Al_jGa_{1-j}N ($0 < j < 1$, $e > j$) are mentioned. In the case of the monolayer in which thickness much more in the case of a superstructure does not form more preferably 100A or less of 70A or less of 10–40A and superstructures, it can be made into the layer which consists of the above-mentioned presentation although especially the thickness of each class which forms a multilayers layer is not limited. Moreover, even if there are few large layers of bandgap energy and small layers, either may be made to dope n mold impurity, when n mold cladding layer is a multilayers layer which consists of a large layer of bandgap energy, and a small layer of bandgap energy. Moreover, when doping in both the large layer of bandgap energy, and a small layer, the amount of dopes may be the same or may differ.

[0028] In [barrier layer 5] this invention, a nitride semi-conductor of a presentation with which an emission peak wavelength is set to 370nm or less is mentioned as a barrier layer 5. The nitride semi-conductor of In_gGa_{1-g}N ($0 < g < 0.1$) is mentioned preferably. Although In presentation ratio of a barrier layer makes In presentation ratio small as an emission peak wavelength turns into short wavelength, In presentation ratio becomes almost close to zero. Especially as thickness of a barrier layer, although not limited, the thickness of extent from which the quantum effectiveness is acquired is mentioned, for example, it is 0.001–0.01 micrometers preferably, and is 0.003–0.007 micrometers more preferably. It is desirable in respect of a radiant power output in thickness being the above-mentioned range.

Moreover, a barrier layer uses the above-mentioned In_gGa_{1-g}N other than the above single quantum well structures as a well layer, and is better than this well layer also as multiplex quantum well structure where bandgap energy consists of a barrier layer which consists of a large presentation. Moreover, an impurity may be doped to a barrier layer.

[0029] Moreover, especially if an emission peak wavelength is In presentation ratio used as 370nm or less as adjustment of In presentation ratio of a barrier layer, it will not be limited, but the value calculated, for example from the formula of the following theoretical value as a concrete value can be mentioned as an approximation-value. However, since the quantum level which takes quantum well structure is formed, the energy (Elambda) of wavelength becomes larger than the bandgap energy (Eg) of InGaN, and the wavelength which is made to actually emit light and is obtained tends to shift to a short wavelength side from the luminescence wavelength called for from a formula etc.

[0030] [The formula of a theoretical value]

$$Eg = (1 - \chi) 3.40 + 1.95\chi - B\chi(1 - \chi)$$

the presentation ratio of bandgap energy χ :In of a wavelength (nm) = $1240/\lambda E_g$:InGaN well layer — the bandgap energy B:Boeing parameter of bandgap energy 1.95(eV):In of 3.40(eV):GaN is shown, and it may be 1–6eV. Thus, although conventionally referred to as 1eV from SIMS analysis etc. in the latest research, having assumed that there was no distortion in a crystal, the Boeing parameter is changed because it is becoming clear for extent which distortion produces by the rate of In presentation ratio, the case where thickness is thin, etc. to differ, and to be set to 1eV or more.

[0031] Although there is a difference a little, it is adjusted to the oscillation wavelength considered from concrete In presentation ratio called for from SIMS analysis of a well layer etc. as mentioned above, and the oscillation wavelength at the time of making it actually oscillate so that it may become the wavelength for which actual oscillation wavelength asks.

[0032] In [p mold cladding layer 6] this invention, although it is the presentation which becomes larger than the bandgap energy of a barrier layer 5 as a p mold cladding layer 6, and it will not be limited especially if the carrier to a barrier layer 5 shuts up and it can **, the thing of Al_fGa_{1-f}N ($0 < f < 0.4$, preferably 0.15 < f < 0.3) is mentioned preferably. When p mold cladding layer consists of such AlGaN, it is desirable at the point which the carrier to a barrier layer shuts up. Although especially the thickness of p mold cladding layer is not limited, it is 0.01–0.15 micrometers preferably, and is 0.04–0.08 micrometers more preferably. Although especially p mold high impurity concentration of p mold cladding layer is not limited, it is 1×10^{18} to $1 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ preferably, and is 1×10^{19} to $5 \times 10^{20}/\text{cm}^3$ more preferably. It is desirable at the point of reducing a bulk resistor, without reducing crystallinity as p mold high impurity concentration is the above-mentioned range.

[0033] p mold cladding layer can also be used as the multilayers layer (a superstructure is included) other than the above monolayers. In the case of a multilayers layer, it should just be the multilayers layer which consists of above Al_fGa_{1-f}N and a nitride semi-conductor layer with bandgap energy smaller than it, but, for example as a small layer of bandgap energy, In_kGa_{1-k}N ($0 < k < 1$) and Al_jGa_{1-j}N ($0 < j < 1$, $f > j$) are mentioned like the case of n mold cladding layer. In the case of the monolayer in which thickness much more in the case of a superstructure does not form more preferably 100A or less of 70A or less of 10–40A and superstructures, it can be made into the layer which consists of the above-mentioned presentation although especially the thickness of each class which forms a multilayers layer is not limited. Moreover, even if there are few large layers of bandgap energy and small layers, either may be made to dope p mold impurity, when p mold cladding layer is a multilayers layer which consists of a large layer of bandgap energy, and a small layer of bandgap energy. Moreover, when doping in both the large layer of bandgap energy, and a small layer, the amount of dopes may be the same or may differ.

[0034] [p mold contact layer 7] It is the nitride semi-conductor which comes to contain AlGaN of the above-mentioned p mold impurity content.

[0035] Moreover, in this invention, various things can be used for p electrode and n electrode, are suitably chosen from a well-known electrode material etc., and are used for them. That the example as an electrode is indicated to be by the below-mentioned example is mentioned. Moreover, although this invention mentioned and explained drawing 1 as a gestalt of 1 operation of component structure, as long as an emission peak wavelength is 370nm or less and are specific n mold contact layer of above this inventions, and p mold contact layer, it can acquire the effectiveness of this invention and may form other layers for improvement in component properties, such as electrostatic pressure-proofing, forward voltage, and a life property, in addition to drawing 1.

[0036] Moreover, the component of this invention is performing annealing processing, in order to form the p side layer into p mold and to consider as low resistance. After growing up the gallium nitride system compound semiconductor with which p mold impurity was doped by vapor growth, it heat-treats at the temperature of 400 degrees C or more among the ambient atmosphere which does not contain hydrogen substantially, and the approach of using as p mold is mentioned by taking out hydrogen from the gallium nitride system compound semiconductor with which p mold impurity was doped, as indicated by patent No. 2540791 as annealing processing.

[0037]

[Example] The example which is the gestalt of 1 operation of this invention is given to below, and this invention is further explained to it at a detail. However, this invention is not limited to this.

[0038] The [example 1] example 1 produces the nitride semiconductor device of drawing 1.

(Substrate 1) A front face is cleaned for the substrate 1 which consists of sapphire (C side) at 1050 degrees C among a hydrogen ambient atmosphere in a reaction container.

[0039] (Buffer layer 2) Then, the buffer layer 2 which consists of GaN on a substrate 1 at 510 degrees C using ammonia and TMG (trimethylgallium) is grown up by about 200A thickness among a hydrogen ambient atmosphere.

[0040] (n mold contact layer 3) Next, TMG, TMA (trimethylaluminum), ammonia, and a silane (SiH4) are used at 1050 degrees C, and n mold contact layer 3 which consists of n mold aluminum $0.04\text{Ga}0.96\text{N}$ which doped Si $5\times 10^{18}/\text{cm}^3$ is grown up by 4-micrometer thickness.

[0041] (n mold cladding layer 4) Next, TMG, TMA, ammonia, and a silane are used at 1050 degrees C, and n mold cladding layer 4 which consists of n mold aluminum $0.18\text{Ga}0.82\text{N}$ which doped Si $5\times 10^{17}/\text{cm}^3$ is formed by 400A thickness.

[0042] (Barrier layer 5) Next, TMI, TMG, and ammonia are used at 700 degrees C among nitrogen-gas-atmosphere mind, and the barrier layer which consists of undoping InGaN is grown up by 55A thickness. In presentation ratio is a minute amount (almost zero) at extent which cannot be measured.

[0043] (p mold cladding layer 6) Next, TMG, TMA, ammonia, and Cp2Mg (magnesium cyclopentadienyl) are used at 1050 degrees C among a hydrogen ambient atmosphere, and p mold cladding layer 6 which consists of aluminum $0.2\text{Ga}0.8\text{N}$ which doped Mg $1\times 10^{20}/\text{cm}^3$ is grown up by 600A thickness.

[0044] On p mold cladding layer 6, then, TMG, TMA, (p mold contact layer 7) 2nd p mold contact layer 7b which consists of aluminum $0.04\text{Ga}0.96\text{N}$ which doped Mg $1\times 10^{19}/\text{cm}^3$ is grown up by 0.1-micrometer thickness using ammonia and Cp2Mg. Then, 2nd p mold contact layer 7b which consists of aluminum $0.01\text{Ga}0.99\text{N}$ which adjusted the flow rate of gas and doped Mg $2\times 10^{21}/\text{cm}^3$ is grown up by 0.02-micrometer thickness.

[0045] A wafer picks out from a reaction container, the mask of a predetermined configuration forms in the front face of p mold contact layer 7 of the maximum upper layer, RIE (reactive ion etching) equipment performs etching from a p mold contact layer side, and after performing annealing for a wafer at 700 degrees C in a reaction container after growth termination and among nitrogen-gas-atmosphere mind and forming p type layer into low resistance further, as shown in drawing 1, the front face of n mold contact layer 3 exposes.

[0046] p pad electrode 10 which consists of Au for bondings is mostly formed by 0.2-micrometer thickness after etching on the p electrode 8 and the p electrode 8 of the translucency of 1st p mold contact layer 7a of p mold contact layer 7 in the maximum upper layer which contains nickel and Au of 200A of thickness on the whole surface. The n electrode 9 containing W and aluminum is formed in the front face of n mold contact layer 3 exposed by etching on the other hand. In order to protect the front face of the p electrode 8 finally, after forming the insulator layer which consists of SiO₂, a scribe separates a wafer and it considers as the LED component of 350-micrometer angle.

[0047] In the forward voltage of 20mA, as for this LED component, an emission peak wavelength shows 370nm, Vf is 3.8V and an output is 2.0mW. The optical ejection effectiveness of LED of an example 1 becomes about 2.5 times to that in which the conventional n mold and p mold contact layer do not contain aluminum. As mentioned above, a radiant power output can be raised by the ability of a self-absorption to be further prevented [since ohmic contact becomes good. Vf equivalent to the former can be maintained, and] according to the above-mentioned component structure.

[0048]

[Effect of the Invention] As mentioned above, without n mold contact layer and p mold contact layer worsening ohmic contact aluminum presentation ratio, high impurity concentration, and by constituting p mold contact layer from two-layer further, this invention can prevent a self-absorption good, can raise optical ejection effectiveness, and can offer the good nitride semiconductor device of a radiant power output 370nm or less. Furthermore, with Mg concentration of n mold and p mold contact layer, and combination with a specific cladding layer, in addition to prevention of good ohmic contact and a self-absorption, prevention of a crack etc. becomes good and this invention can obtain a better radiant power output.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

JPO and NCIPI are not responsible for any
damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] Drawing 1 is the typical sectional view of LED which is the gestalt of 1 operation of this invention.

[Description of Notations]

- 1 ... Substrate
- 2 ... Buffer layer
- 3 ... n mold contact layer
- 4 ... n mold cladding layer
- 5 ... Barrier layer
- 6 ... p mold cladding layer
- 7 ... p mold contact layer
- 7b ... 2nd p mold contact layer
- 7a ... 1st p mold contact layer
- 8 ... p electrode
- 9 ... n electrode
- 10 ... Pad electrode

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-203385

(P2001-203385A)

(43)公開日 平成13年7月27日 (2001.7.27)

(51)Int.Cl⁷

H 0 1 L 33/00

識別記号

F I

H 0 1 L 33/00

テーマコード^{*}(参考)

C 5 F 0 4 1

審査請求 未請求 請求項の数 6 O.L (全 8 頁)

(21)出願番号 特願2000-10346(P2000-10346)

(22)出願日 平成12年1月17日 (2000.1.17)

(71)出願人 000226057

日亜化学工業株式会社

徳島県阿南市上中町岡491番地100

(72)発明者 森田 大介

徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
学工業株式会社内

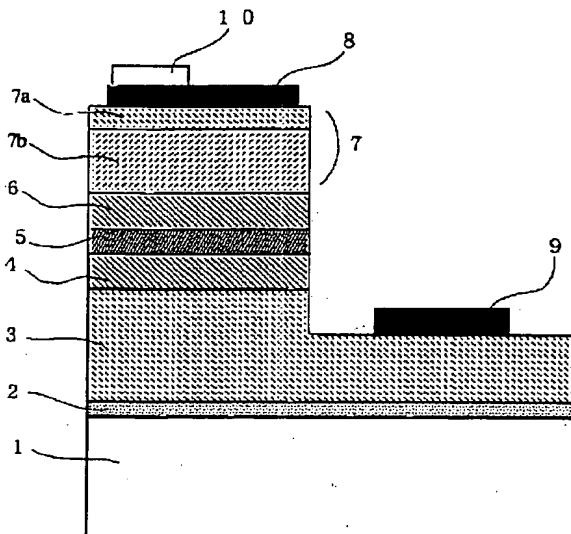
Fターム(参考) 5F041 AA04 AA11 AA31 CA04 CA05
CA34 CA40 CA65 CA85 CA87

(54)【発明の名称】窒化物半導体発光ダイオード

(57)【要約】

【課題】 良好なオーム接觸が得られると共に、自己吸収を抑制して発光出力の向上が可能な発光ピーク波長が370 nm以下の窒化物半導体発光ダイオードを提供することである。

【解決手段】 活性層が発光ピーク波長が370 nm以下の窒化物半導体層からなり、p型コンタクト層が、p電極と接する側にp型不純物を高濃度で含有するA_{1-a}Ga_{1-a}N ($0 \leq a < 0.05$) を含んでなる第1のp型コンタクト層と、第1のp型コンタクト層の活性層側に第1のp型コンタクト層と接してp型不純物を第1のp型コンタクト層より低濃度で含有しA₁組成比が第1のp型コンタクト層より高いA_{1-b}Ga_{1-b}N ($0 < b < 0.1$) を含んでなる第2のp型コンタクト層とから形成されてなり、さらにn電極と接するn型コンタクト層が、A_{1-d}Ga_{1-d}N ($0 < d < 0.1$) を含んでなる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に、少なくともn型窒化物半導体層、活性層、及びp型窒化物半導体層を有する窒化物半導体素子において、前記活性層が、発光ピーク波長が370nm以下の窒化物半導体層からなり、前記p型窒化物半導体層として、p電極と接するp型コンタクト層が、p電極と接する側に、p型不純物を高濃度で含有する $A_{1-a}Ga_{1-a}N$ ($0 \leq a < 0.05$) を含んでなる第1のp型コンタクト層と、前記第1のp型コンタクト層の活性層側に第1のp型コンタクト層と接して、p型不純物を第1のp型コンタクト層より低濃度で含有し、さらにA1組成比が第1のp型コンタクト層より高い $A_{1-b}Ga_{1-b}N$ ($0 < b < 0.1$) を含んでなる第2のp型コンタクト層とから形成されてなり、

さらに、前記n型窒化物半導体層として、n電極と接するn型コンタクト層が、 $A_{1-d}Ga_{1-d}N$ ($0 < d < 0.1$) を含んでなることを特徴とする窒化物半導体発光ダイオード。

【請求項2】 前記p電極と接する第1のp型コンタクト層が、p型不純物を $1 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{22}/cm^3$ 含有してなることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【請求項3】 前記第2のp型コンタクト層が、p型不純物を $1 \times 10^{20}/cm^3$ 以下含有してなることを特徴とする請求項1又は2に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【請求項4】 前記p型コンタクト層における第1のp型コンタクト層の膜厚が、100~500オングストロームであり、さらに第2のp型コンタクト層の膜厚が、400~2000オングストロームであることを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【請求項5】 前記n型コンタクト層が、n型不純物を $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19}/cm^3$ 含有してなることを特徴とする請求項4に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【請求項6】 前記活性層とn型コンタクト層との間に、 $A_{1-e}Ga_{1-e}N$ ($0 < e < 0.3$) を含んでなる第1の窒化物半導体層を有し、更に、前記活性層とp型コンタクト層との間に、 $A_{1-f}Ga_{1-f}N$ ($0 < f < 0.4$) を含んでなる第2の窒化物半導体層を有することを特徴とする請求項1に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発光ダイオード(LED)、レーザダイオード(LD)、太陽電池、光センサーなどの発光素子、受光素子に使用される窒化物半導体素子($In_xAl_yGa_{1-x-y}N$, $0 \leq x, 0 \leq y, x+y \leq 1$)に関し、特に、発光ピーク波長が370nm

以下の紫外領域に発光する窒化物半導体発光ダイオードに関する。

【0002】

【従来の技術】近年、紫外LEDが実用可能となってい。例えば、応用物理、第68巻、第2号(1999)、p152~p155には、サファイア基板上に、 GaN バッファ層、n型 GaN コンタクト層(膜厚: 4μm)、n型 A_1GaN クラッド層、アンドープ $InGaN$ の活性層(I_n組成はほとんどゼロ)、p型 A_1GaN クラッド層、p型 GaN コンタクト層(膜厚: 0.12μm)が積層されてなる窒化物半導体素子が記載されている。そして、この紫外LEDは、一定条件下で、発光ピークが371nmの場合には発光出力が5mWであるのに対して、発光波長をこれより短波長にしたときにはn型及びp型コンタクト層が GaN であるために自己吸収がおこり、発光出力が急激に低くなることが記載されている。更に、この発光出力の低下を防止し、発振波長の短波長化を可能とするためには、n型及びp型コンタクト層を、 A_1GaN として自己吸収を防止できることが示唆されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、単に、自己吸収を十分に防止できる程度にA1組成比の高い A_1GaN でコンタクト層を成長させると、電極との良好なオーミック接触が得られ難くなる。この原因は、恐らく、 A_1GaN が物性的にドーパントの不活性化を引き起こしたり、フェルミ準位の変動で電極となる金属との仕事関数の差に変動が生じたりするために、電極との良好なオーミック接触が得られ難くなるのではないかと考えられる。このようなオーミック接触の低下は、p型コンタクト層で大きい。また、上記のように、A1組成を含ませることでドーパントの不活性化が生じオーミック接触が得られ難くなる点を改善するために、コンタクト層に不純物を多くドープすると、不純物の量にはほぼ比例して不純物準位が形成されるために、返って自己吸収が大きくなり、結晶性の低下などで発光出力が低下する場合がある。

【0004】またさらに、コンタクト層を GaN として膜厚を薄くすることで、相対的に自己吸収を低下させることも考えられるが、例えばp型コンタクト層の膜厚を薄くすると、素子特性が十分でなくなり、さらに、n型コンタクト層の膜厚を薄くすると、n型コンタクト層を露出させる際に操作が煩雑となると共に露出させることが困難となる。

【0005】このように、従来技術における発光ピーク波長が370nm以下の発光ダイオードでは、コンタクト層で自己吸収が生じて発光出力が低下してしまうが、 GaN による自己吸収を防止するために、単にコンタクト層を A_1GaN として成長させるとオーミック接触の低下が生じ、さらにオーミック接触を得るために不純物

のドープ量を増加させると不純物準位の形成や結晶欠陥の増加によって自己吸収が生じてしまう。従って、自己吸収の防止と共にオーミック接触を良好にすることが望まれる。

【0006】そこで、本発明の目的は、良好なオーミック接触が得られると共に、自己吸収を抑制して発光出力の向上が可能な発光ピーク波長が370 nm以下の窒化物半導体発光ダイオードを提供することである。

【0007】

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、下記(1)～(6)の構成により本発明の目的を達成することができる。

(1) 基板上に、少なくともn型窒化物半導体層、活性層、及びp型窒化物半導体層を有する窒化物半導体素子において、前記活性層が、発光ピーク波長が370 nm以下の窒化物半導体層からなり、前記p型窒化物半導体層として、p電極と接するp型コンタクト層が、p電極と接する側に、p型不純物を高濃度で含有するA₁_aGa_{1-a}N (0≤a<0.05)を含んでなる第1のp型コンタクト層と、前記第1のp型コンタクト層の活性層側に第1のp型コンタクト層と接して、p型不純物を第1のp型コンタクト層より低濃度で含有し、さらにA₁組成比が第1のp型コンタクト層より高いA_{1-b}Ga_{1-b}N (0<b<0.1)を含んでなる第2のp型コンタクト層とから形成されてなり、さらに、前記n型窒化物半導体層として、n電極と接するn型コンタクト層が、A_{1-d}Ga_{1-d}N (0<d<0.1)を含んでなることを特徴とする窒化物半導体発光ダイオード。

(2) 前記p電極と接する第1のp型コンタクト層が、p型不純物を1×10¹⁹～1×10²²/cm³含有してなることを特徴とする前記(1)に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

(3) 前記第2のp型コンタクト層が、p型不純物を1×10²⁰/cm³以下含有してなることを特徴とする前記(1)又は(2)に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

(4) 前記p型コンタクト層における第1のp型コンタクト層の膜厚が、100～500オングストロームであり、さらに第2のp型コンタクト層の膜厚が、400～2000オングストロームであることを特徴とする前記(1)に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

(5) 前記n型コンタクト層が、n型不純物を1×10¹⁷～1×10¹⁹/cm³含有してなることを特徴とする前記(4)に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

(6) 前記活性層とn型コンタクト層との間に、A_{1-e}Ga_{1-e}N (0<e<0.3)を含んでなる第1の窒化物半導体層を有し、更に、前記活性層とp型コンタクト層との間に、A_{1-f}Ga_{1-f}N (0<f<0.4)を含んでなる第2の窒化物半導体層を有することを特徴とする前記(1)に記載の窒化物半導体発光ダイオード。

【0008】つまり、本発明は、n型コンタクト層を特定のA₁組成比からなるA₁GaNとし、さらに、p型コンタクト層を、p型不純物濃度が高くA₁組成比の小さい第1のp型コンタクト層と、p型不純物濃度が低くA₁組成比の高い第2のp型コンタクト層とから形成し、p型不純物濃度の高い第1のコンタクト層をp電極と接する側に形成してなることにより、良好なオーミック接触が得られると共に自己吸収を抑制でき、発光出力の良好な発光ピーク波長が370 nm以下の窒化物半導体発光ダイオードを得ることができる。ここで、本発明においては、p型コンタクト層におけるp型不純物濃度の高い又は低い、及びA₁組成比の高い又は低いとは、p型コンタクト層を構成する第1のp型コンタクト層と第2のp型コンタクト層での相対的な関係を示す。

【0009】本発明者は、前記したように単に自己吸収の防止のためにA₁組成を含ませると、不純物の不活性化等によってオーミック接触の低下を引き起こすと言った点について種々検討した結果、n型コンタクト層を特定のA₁組成比のA₁GaNとし、さらにp型コンタクト層をオーミック接触を得るための層と素子特性を維持するため膜厚を確保するための層との2層構造とすることを考えた。そして、本発明者は、上記のようにp型不純濃度が高くA₁組成比の低いp電極と接する第1のp型コンタクト層と、不純物濃度の低いA₁組成比の高い第2のp型コンタクト層とでp型コンタクト層を形成し、さらに特定のA₁組成比からなるn型コンタクト層と組み合わせることで、オーミック接触が良好で、且つ自己吸収の防止が可能となり、発光出力の良好な窒化物半導体発光ダイオードを得ることを達成した。

【0010】さらに、本発明において、第1のp型コンタクト層が、p型不純物を1×10¹⁹～1×10²²/cm³、好ましくは5×10²⁰～5×10²¹/cm³含有してなると、良好なオーミック接触を得る点で好ましい。またさらに、本発明において、第2のp型コンタクト層が、p型不純物を1×10²⁰/cm³以下、好ましくは5×10¹⁸～5×10¹⁹/cm³含有してなると、素子特性を維持するためにp型コンタクト層の膜厚を厚くしても、自己吸収を防止できる点で好ましい。

【0011】またさらに本発明において、p型コンタクト層における第1のp型コンタクト層の膜厚が、100～500オングストローム、好ましくは150～300オングストロームであると、p型不純物濃度を高くしても膜厚を薄く設定してあると不純物準位による自己吸収が相対的に小さくできると共に、p電極とのオーミック接触を良好と/or ことができ、さらに第2のp型コンタクト層の膜厚が、400～2000オングストローム、好ましくは800～1200オングストロームであると、自己吸収を防止できると共に、素子特性を維持するのに好ましい。

【0012】更に、本発明は、A₁を含んでなるn型コ

ンタクト層が、n型不純物濃度が、 $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ 、好ましくは $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ あると、自己吸収の防止と共に、オーミック接触を維持し、発光出力を向上させる点で好ましい。このように、n型コンタクト層のA1組成比と、n型不純物濃度とを特定して組み合わせると、p型コンタクト層の場合と同様に、オーミック接触及びクラック防止、発光出力の向上の点で好ましい。

【0013】更に、本発明は、前記活性層とn型コンタクト層との間に、 $\text{Al}_e\text{Ga}_{1-e}\text{N}$ ($0 < e < 0.3$) を含んでなる第1の窒化物半導体層を有し、更に、前記活性層とp型コンタクト層との間に、 $\text{Al}_f\text{Ga}_{1-f}\text{N}$ ($0 < f < 0.4$) を含んでなる第2の窒化物半導体層を有すると、活性層へのキャリアの閉じ込めを良好にでき、発光出力向上の点で好ましい。更に、第1の窒化物半導体層及び第2の窒化物半導体層のそれぞれのA1組成比を上記範囲とし、前記のコンタクト層のA1組成比及び不純物濃度とを組み合わせると、クラック発生の防止、オーミック接触を良好にでき、発光出力の向上の点で好ましい。前記第1の窒化物半導体層及び第2の窒化物半導体層は、クラッド層としての機能を有するので、本発明においては、以下、第1の窒化物半導体層をn型クラッド層、第2の窒化物半導体層をp型クラッド層とする。しかし、これに限定されるものではない。

【0014】

【発明の実施の形態】以下に、図1を用いて本発明を更に詳細に説明する。図1は、本発明の一実施の形態である窒化物半導体素子の模式的断面図である。図1には、基板1上に、バッファ層2、 $\text{Al}_d\text{Ga}_{1-d}\text{N}$ ($0 < d < 0.1$) を含んでなるn型コンタクト層3、 $\text{Al}_e\text{Ga}_{1-e}\text{N}$ ($0 < e < 0.3$) を含んでなるn型クラッド層4、 $\text{In}_g\text{Ga}_{1-g}\text{N}$ ($0 \leq g < 0.1$) の活性層5、 $\text{Al}_f\text{Ga}_{1-f}\text{N}$ ($0 < f < 0.4$) を含んでなるp型クラッド層6、 $\text{Al}_b\text{Ga}_{1-b}\text{N}$ ($0 < b < 0.1$) を含んでなる第2のp型コンタクト層7bと、 $\text{Al}_a\text{Ga}_{1-a}\text{N}$ ($0 \leq a < 0.05$) を含んでなる第1のp型コンタクト層7aとからなるp型コンタクト層7を積層成長させてなり、発光ピーク波長が370nm以下の窒化物半導体素子が記載されている。そして、n型コンタクト層3にはn電極が、p型コンタクト層7の第1のp型コンタクト層7aに接してp電極がそれぞれ形成されている。まず、本発明のn型コンタクト層3及びp型コンタクト層7について記載する。

【0015】[n型コンタクト層3] 本発明において、n型コンタクト層3としては、少なくとも $\text{Al}_d\text{Ga}_{1-d}\text{N}$ ($0 < d < 0.1$ 、好ましくは $0.01 < d < 0.05$) を含んでなる窒化物半導体層である。A1組成比が上記範囲であると、自己吸収の防止と共に、結晶性とオーミック接触の点で好ましい。更に前記n型コンタクト層3は、n型不純物を $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$

m^3 、好ましくは $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ の濃度で含有していると、オーミック接触の維持、クラック発生の防止、結晶性の維持の点で好ましい。このようにn型コンタクト層を構成するA1組成比とn型不純物濃度を組み合わせると、自己吸収を防止できると共に、オーミック接触やクラック防止の点で好ましい。n型不純物としては、特に限定されないが、例えば、Si、Ge等が挙げられ、好ましくはSiである。n型コンタクト層3の膜厚は、特に限定されないが、 $0.1 \sim 2.0 \mu\text{m}$ が好ましく、より好ましくは $1 \sim 10 \mu\text{m}$ である。膜厚がこの範囲であると、界面付近（例えばn型クラッド層との界面付近）の結晶性（下地として）と抵抗率の低下の点で好ましい。

【0016】[p型コンタクト層7] 本発明において、p型コンタクト層7としては、少なくともp電極と接するp型不純物濃度が高くA1組成比の低い第1のp型コンタクト層7aと、p型不純物濃度が低くA1組成比の高い第2のp型コンタクト層7bとから形成されている。このように、p型不純物濃度とA1組成比が異なる2種類の層でp型コンタクト層7を形成することにより、第1のp型コンタクト層7aで良好なオーミック接触を得ることができ、さらに素子特性を維持できる程度の膜厚にp型コンタクト層を調整する場合、第2のp型コンタクト層7bの膜厚を厚くした場合でも、A1組成比が高いので自己吸収を防止することができる。つまり、p型コンタクト層7では、オーミック接触を得るために第1のp型コンタクト層7aと、自己吸収を防止しながら素子特性の維持できる程度に膜厚を確保するための第2のp型コンタクト層7bとの2層からなる。以下に第1のp型コンタクト層7a及び第2のp型コンタクト層7bについて説明する。第1のp型コンタクト層7aは、第2のp型コンタクト層7bに比べて不純物濃度が高く、A1組成比が低く設定されている。

【0017】このような第1のp型コンタクト層7aとしては、 $\text{Al}_a\text{Ga}_{1-a}\text{N}$ ($0 \leq a < 0.05$ 、好ましくは $0 < a < 0.01$) を含んでなる窒化物半導体層を挙げることができる。A1組成比が上記範囲であるとp型不純物濃度を高濃度にドープしても、不純物の不活性化を防止でき、p電極との良好なオーミック接触を得ることができ好ましい。また、第1のp型コンタクト層7aが上記の範囲内でA1組成を含んでなると自己吸収の防止の点で好ましく、さらに結晶性の点でも好ましい。また、第1のp型コンタクト層7aのA1組成比は、上記範囲内で、第2のp型コンタクト層7bのA1組成比よりも低くなるように調整される。

【0018】第1のp型コンタクト層7aのp型不純物濃度としては、特に限定されないが、p電極とのオーミック接触が良好に得られる程度が好ましく、例えば具体的には、 $1 \times 10^{19} \sim 1 \times 10^{22} / \text{cm}^3$ 、好ましくは $5 \times 10^{20} \sim 5 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ である。p型不純物濃

度が上記範囲であると、オーミック接触を良好に得ることができ好ましい。第1のp型コンタクト層7aのp型不純物濃度は、上記範囲内で第2のp型コンタクト層7bの不純物濃度より高くなるように調整される。また、第1のp型コンタクト層7aの膜厚としては、特に限定されないが、p電極とのオーミック接触が良好となる程度の膜厚であればよく、例えば具体的には、100～500オングストローム、好ましくは150～300オングストロームである。このような膜厚であると、A1組成比を低くしても膜厚が比較的薄いので自己吸収を防止でき、さらに、p型不純物を高濃度に含有して良好なオーミック接触を得る点で好ましい。

【0019】次に、第2のp型コンタクト層7bとしては、 $A_{1-b}Ga_{1-b}N$ ($0 < b < 0.1$ 、好ましくは $0.01 < b < 0.05$) を含んでなる窒化物半導体層である。A1組成比が上記範囲であると、n型コンタクト層の場合と同様に自己吸収の防止の点で好ましく、さらに、結晶性とオーミック接触の点でも好ましい。また、第2のp型コンタクト層7bのA1組成比は、上記範囲内で第1のp型コンタクト層7aより高くなるように調整される。第2のp型コンタクト層7bのp型不純物濃度は、第2のp型コンタクト層7bがp型を示す程度に含有されていることが望ましく、例えば具体的には、 $1 \times 10^{20}/cm^3$ 以下、好ましくは $5 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{19}/cm^3$ である。p型不純物濃度が上記範囲であると、不純物準位の形成による自己吸収の防止の点で好ましい。第2のp型コンタクト層7bのp型不純物濃度は、上記範囲内で第1のp型コンタクト層7aより低濃度に調整される。

【0020】第2のp型コンタクト層7bの膜厚としては、特に限定されないが、第2のp型コンタクト層7bが400～1200オングストローム、好ましくは800～1200オングストロームである。第2のp型コンタクト層7bの膜厚が上記範囲であると、自己吸収を防止しながら素子特性を維持できる程度の膜厚に調整できる点で好ましい。p型コンタクト層7に含有されるp型不純物としては、特に限定されないが、例えば好ましくはMgが挙げられる。

【0021】また、ここで、p型コンタクト層7を構成する第1のp型コンタクト層7aと第2のp型コンタクト層7bは、上記に示したように、不純物濃度やA1組成比が重複する部分があるが、それぞれ記載された範囲で第1のp型コンタクト層7aが、第2のp型コンタクト層7bに対して、不純物濃度が高くてA1組成比が低くなるように調整されることで良好な効果を得ることができる。仮に、p型コンタクト層7を、A1組成比の低い層のみ、あるいは不純物濃度の高い層のみなどで形成すると、オーミック接触は良好であっても、自己吸収の防止は十分満足できない等、良好なオーミック接触と共に自己吸収の防止の両者を得られ難くなる。また、p型

コンタクト層7は、p型不純物濃度が高くA1組成比の小さい第1のp型コンタクト層7aにより良好なオーミック接触が得られ、p型不純物濃度が低くA1組成比が大きい第2のp型コンタクト層7bにより自己吸収を防止すると共に素子特性の維持ができる、といったようにオーミック接触と自己吸収の防止をそれぞれの層によって得るよう構成している。そして第1のp型コンタクト層7aと第2のp型コンタクト層7bとの層が相乗的に作用して、良好なオーミック接触と自己吸収の防止によって、発光出力の良好な素子を得ることができる。また、現状の窒化物半導体では、n型よりもp型形成が困難であり、また素子構造的にp側面発光により特にp側の良好なオーミック接触とp側の自己吸収の防止が大事である。

【0022】またさらに、上記のようにn型コンタクト層3のA1組成比を特定すること、好ましくはA1組成比に加えて不純物濃度を特定すること、加えて、p型コンタクト層7をp型不純物濃度の高いA1組成比の低い第1のp型コンタクト層7aとp型不純物濃度が低くA1組成比の高い第2のp型コンタクト層7bとで形成すること、を組み合わせると、オーミック接触の低下を引き起こすことなく自己吸収をより良好に防止でき、発光出力の向上の点でより好ましい。

【0023】更に、以下に素子を構成するその他の各層について説明する。

【基板1】本発明において、基板1としては、サファイアC面、R面又はA面を主面とするサファイア、その他、スピネル($MgAl_2O_4$)のような絶縁性の基板の他、SiC(6H、4H、3Cを含む)、Si、ZnO、GaAs、GaN等の半導体基板を用いることができる。

【0024】【バッファ層2】本発明において、バッファ層2としては、 $Ga_hAl_{1-h}N$ (但し h は $0 < h \leq 1$ の範囲である。) からなる窒化物半導体であり、好ましくはA1の割合が小さい組成ほど結晶性の改善が顕著となり、より好ましくはGaNからなるバッファ層2が挙げられる。バッファ層2の膜厚は、 $0.002 \sim 0.5 \mu m$ 、好ましくは $0.005 \sim 0.2 \mu m$ 、更に好ましくは $0.01 \sim 0.02 \mu m$ の範囲に調整する。バッファ層2の膜厚が上記範囲であると、窒化物半導体の結晶モフォロジーが良好となり、バッファ層2上に成長させる窒化物半導体の結晶性が改善される。バッファ層2の成長温度は、 $200 \sim 900^\circ C$ であり、好ましくは $400 \sim 800^\circ C$ の範囲に調整する。成長温度が上記範囲であると良好な多結晶となり、この多結晶が種結晶としてバッファ層2上に成長させる窒化物半導体の結晶性を良好にでき好ましい。また、このような低温で成長させるバッファ層2は、基板の種類、成長方法等によっては省略してもよい。

【0025】【n型コンタクト層3】上記のn型不純物

含有のAlGaNを含んでなる窒化物半導体である。
【0026】[n型クラッド層4]本発明において、n型クラッド層4としては、活性層5のバンドギャップエネルギーより大きくなる組成であり、活性層5へのキャリアの閉じ込めが可能であれば特に限定されないが、好ましい組成としては、 $A_{1-e}Ga_eN$ ($0 < e < 0.3$ 、好ましくは $0.1 < e < 0.2$) のものが挙げられる。n型クラッド層が、このようなAlGaNからなると、活性層へのキャリアの閉じ込めの点で好ましい。n型クラッド層の膜厚は、特に限定されないが、好ましくは $0.01 \sim 0.1 \mu m$ であり、より好ましくは $0.03 \sim 0.06 \mu m$ である。n型クラッド層のn型不純物濃度は、特に限定されないが、好ましくは $1 \times 10^{17} \sim 1 \times 10^{20} / cm^3$ であり、より好ましくは $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{19} / cm^3$ である。不純物濃度がこの範囲であると、抵抗率及び結晶性の点で好ましい。

【0027】n型クラッド層は、上記のような単一層の他に、多層膜層（超格子構造を含む）とすることもできる。多層膜層の場合は、上記の $A_{1-e}Ga_{e-j}N$ と、それよりバンドギャップエネルギーの小さい窒化物半導体層とからなる多層膜層であればよいが、例えばバンドギャップエネルギーの小さい層としては、 $In_kGa_{1-k}N$ ($0 \leq k < 1$)、 $A_{1-j}Ga_{j-e}N$ ($0 \leq j < 1$ 、 $e > j$) が挙げられる。多層膜層を形成する各層の膜厚は、特に限定されないが、超格子構造の場合は、一層の膜厚が100オングストローム以下、好ましくは70オングストロームと、超格子構造を形成しない単一層の場合は、上記の組成からなる層とすることができます。また、n型クラッド層がバンドギャップエネルギーの大きい層と、バンドギャップエネルギーの小さい層からなる多層膜層である場合、バンドギャップエネルギーの大きい層及び小さい層の少なくともいずれか一方にn型不純物をドープさせてもよい。また、バンドギャップエネルギーの大きい層及び小さい層の両方にドープする場合は、ドープ量は同一でも異なってもよい。

【0028】[活性層5]本発明において、活性層5としては、発光ピーク波長が370nm以下となるような組成の窒化物半導体が挙げられる。好ましくは $In_gGa_{1-g}N$ ($0 \leq g < 0.1$) の窒化物半導体が挙げられる。活性層のIn組成比は、発光ピーク波長が短波長となるに従いIn組成比を小さくしていくが、In組成比はほとんどゼロに近くなる。活性層の膜厚としては、特に限定されないが、量子効果の得られる程度の膜厚が挙げられ、例えば好ましくは $0.001 \sim 0.01 \mu m$ であり、より好ましくは $0.003 \sim 0.007 \mu m$ である。膜厚が上記範囲であると発光出力の点で好ましい。また、活性層は、上記のような単一量子井戸構造の他に、上記 $In_gGa_{1-g}N$ を井戸層として、この井戸層よりバンドギャップエネルギーが大きい組成からなる障壁

層とからなる多重量子井戸構造としてもよい。また、活性層には、不純物をドープしてもよい。

【0029】また、活性層のIn組成比の調整としては、発光ピーク波長が370nm以下となるIn組成比であれば特に限定されず、具体的な値としては、例えば下記の理論値の計算式から求められる値を近似的な値として挙げることができる。しかし、実際に発光させて得られる波長は、量子井戸構造をとる量子準位が形成されたため、波長のエネルギー（E_h）が $InGaN$ のバンドギャップエネルギー（E_g）よりも大きくなり、計算式などから求められる発光波長より、短波長側へシフトする傾向がある。

【0030】[理論値の計算式]

$$E_g = (1-x) 3.40 + 1.95x - Bx (1-x)$$

$$\text{波長 (nm)} = 1240 / E_g$$

E_g : InGaN井戸層のバンドギャップエネルギー

x : Inの組成比

3.40 (eV) : GaNのバンドギャップエネルギー
1.95 (eV) : InNのバンドギャップエネルギー
B : ボーイングパラメーターを示し、1~6eVとする。このようにボーイングパラメータが変動するのは、最近の研究では、SIMS分析などから、従来は結晶に歪みがないと仮定して1eVとされていたが、In組成比の割合や膜厚が薄い場合等により歪みの生じる程度が異なり、1eV以上となることが明らかとなってきているためである。

【0031】上記のように井戸層のSIMS分析などから求められる具体的なIn組成比から考えられる発振波長と、実際に発振させたときの発振波長とには、やや相違があるものの、実際の発振波長が所望する波長となるように調整される。

【0032】[p型クラッド層6]本発明において、p型クラッド層6としては、活性層5のバンドギャップエネルギーより大きくなる組成であり、活性層5へのキャリアの閉じ込めができるものであれば特に限定されないが、好ましくは、 $A_{1-f}Ga_{f-1}N$ ($0 < f < 0.4$ 、好ましくは $0.15 < f < 0.3$) のものが挙げられる。p型クラッド層が、このようなAlGaNからなると、活性層へのキャリアの閉じ込めの点で好ましい。p型クラッド層の膜厚は、特に限定されないが、好ましくは $0.01 \sim 0.15 \mu m$ であり、より好ましくは $0.04 \sim 0.08 \mu m$ である。p型クラッド層のp型不純物濃度は、特に限定されないが、好ましくは $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{21} / cm^3$ であり、より好ましくは $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{20} / cm^3$ である。p型不純物濃度が上記範囲であると、結晶性を低下させることなくバルク抵抗を低下させる点で好ましい。

【0033】p型クラッド層は、上記のような単一層の他に、多層膜層（超格子構造を含む）とすることもでき

る。多層膜層の場合は、上記の $A_{1-f}G_{a_{1-f}}N$ と、それよりバンドギャップエネルギーの小さい窒化物半導体層とからなる多層膜層であればよいが、例えばバンドギャップエネルギーの小さい層としては、n型クラッド層の場合と同様に、 $I_{n_k}G_{a_{1-k}}N$ ($0 \leq k < 1$)、 $A_{1_j}G_{a_{1-j}}N$ ($0 \leq j < 1$, $f > j$) が挙げられる。多層膜層を形成する各層の膜厚は、特に限定されないが、超格子構造の場合、一層の膜厚が 100 オングストローム以下、好ましくは 70 オングストローム以下、より好ましくは 10~40 オングストロームと、超格子構造を形成しない単一層の場合は、上記の組成からなる層とすることができる。また、p 型クラッド層がバンドギャップエネルギーの大きい層と、バンドギャップエネルギーの小さい層からなる多層膜層である場合、バンドギャップエネルギーの大きい層及び小さい層の少なくともいずれか一方に p 型不純物をドープさせてもよい。また、バンドギャップエネルギーの大きい層及び小さい層の両方にドープする場合は、ドープ量は同一でも異なってもよい。

【0034】[p型コンタクト層7] 上記の p 型不純物含有の A_1GaN を含んでなる窒化物半導体である。

【0035】また、本発明において、p 電極及び n 電極は、種々のものを用いることができ、公知の電極材料等から適宜選択して用いる。電極としての具体例は、後述の実施例に記載されているものが挙げられる。また、本発明は、素子構造の一実施の形態として図1を挙げて説明したが、発光ピーク波長が 370 nm 以下で、上記のような本発明の特定の n 型コンタクト層及び p 型コンタクト層であれば本発明の効果を得ることができ、図1以外に、静電耐圧、順方向電圧、寿命特性等の素子特性の向上のために、その他の層を形成してもよい。

【0036】また、本発明の素子は、p 側層を p 型化して低抵抗とするために、アニーリング処理を行っている。アニーリング処理としては、特許第 2540791 号に記載されているように、気相成長法により、p 型不純物がドープされた窒化ガリウム系化合物半導体を成長させた後、実質的に水素を含まない雰囲気中、400°C 以上の温度で熱処理を行い、p 型不純物がドープされた窒化ガリウム系化合物半導体から水素を出すことにより p 型にする方法が挙げられる。

【0037】

【実施例】以下に、本発明の一実施の形態である実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。しかし、本発明はこれに限定されない。

【0038】[実施例1] 実施例1は、図1の窒化物半導体素子を作製する。

(基板1) サファイア(C面)よりなる基板1を、反応容器内において水素雰囲気中、1050°Cで表面のクリーニングを行う。

【0039】(バッファ層2) 続いて、水素雰囲気中、

510°Cで、アンモニアと TMG (トリメチルガリウム) を用い、基板1上に GaN よりなるバッファ層2を約 200 オングストロームの膜厚で成長させる。

【0040】(n型コンタクト層3) 次に 1050°Cで TMG、TMA (トリメチルアルミニウム)、アンモニア、シラン (SiH_4) を用い、 Si を $5 \times 10^{18}/cm^3$ ドープした n 型 $A_{1.04}G_{a_{0.96}}N$ よりなる n 型コンタクト層3を 4 μm の膜厚で成長させる。

【0041】(n型クラッド層4) 次に 1050°Cで TMG、TMA、アンモニア、シランを用い、 Si を $5 \times 10^{17}/cm^3$ ドープした n 型 $A_{1.18}G_{a_{0.82}}N$ よりなる n 型クラッド層4を 400 オングストロームの膜厚で形成する。

【0042】(活性層5) 次に窒素雰囲気中、700°Cで TMG、TMA、アンモニアを用い、アンドープ $InGaN$ よりなる活性層を 55 オングストロームの膜厚で成長させる。 In 組成比は、測定不可能な程度に微量 (ほとんどゼロ) である。

【0043】(p型クラッド層6) 次に水素雰囲気中、1050°Cで TMG、TMA、アンモニア、 $C_{p_2}Mg$ (シクロペンタジエニルマグネシウム) を用い、 Mg を $1 \times 10^{20}/cm^3$ ドープした $A_{1.02}G_{a_{0.8}}N$ よりなる p 型クラッド層6を 600 オングストロームの膜厚で成長させる。

【0044】(p型コンタクト層7) 続いて、p 型クラッド層6上に、TMG、TMA、アンモニア、 $C_{p_2}Mg$ を用いて、 Mg を $1 \times 10^{19}/cm^3$ ドープした $A_{1.04}G_{a_{0.96}}N$ よりなる第2の p 型コンタクト層7bを 0.1 μm の膜厚で成長させ、その後、ガスの流量を調整して Mg を $2 \times 10^{21}/cm^3$ ドープした $A_{1.01}G_{a_{0.99}}N$ よりなる第2の p 型コンタクト層7bを 0.02 μm の膜厚で成長させる。

【0045】成長終了後、窒素雰囲気中、ウェーハを反応容器内において、700°Cでアニーリングを行い、p 型層をさらに低抵抗化した後、ウェーハを反応容器から取り出し、最上層の p 型コンタクト層7の表面に所定の形状のマスクを形成し、RIE (反応性イオンエッチング) 装置で p 型コンタクト層側からエッチングを行い、図1に示すように n 型コンタクト層3の表面を露出させる。

【0046】エッチング後、最上層にある p 型コンタクト層7の第1の p 型コンタクト層7aのほぼ全面に膜厚 200 オングストロームの Ni と Au を含む透光性の p 電極8と、その p 電極8の上にボンディング用の Au よりなる p パッド電極10を 0.2 μm の膜厚で形成する。一方エッチングにより露出させた n 型コンタクト層3の表面には W と Al を含む n 電極9を形成する。最後に p 電極8の表面を保護するために SiO₂ よりなる絶縁膜を形成した後、ウェーハをスクラップにより分離して 350 μm 角の LED 素子とする。

【0047】このLED素子は順方向電圧20mAにおいて、発光ピーク波長が370nmを示し、 V_f は3.8V、出力は2.0mWである。実施例1のLEDの光取り出し効率は、従来のn型及びp型コンタクト層がA1を含んでいないものに対してほぼ2.5倍となる。以上のように、上記素子構造により、オーミック接触が良好となるので従来と同等の V_f を維持でき、さらに自己吸収を防止できることで発光出力を向上させることができる。

【0048】

【発明の効果】本発明は、上記のように、n型コンタクト層及びp型コンタクト層をA1組成比や不純物濃度、さらにp型コンタクト層を2層から構成することにより、オーミック接触を悪化させることなく良好に自己吸収を防止して光取り出し効率を向上させ、370nm以下の発光出力の良好な窒化物半導体素子を提供することができる。更に本発明は、n型及びp型コンタクト層のMg濃度や、特定のクラッド層との組み合わせにより、良好なオーミック接触と自己吸収の防止に加えて、クラ

ックなどの防止が良好となり、より良好な発光出力を得ることができる。

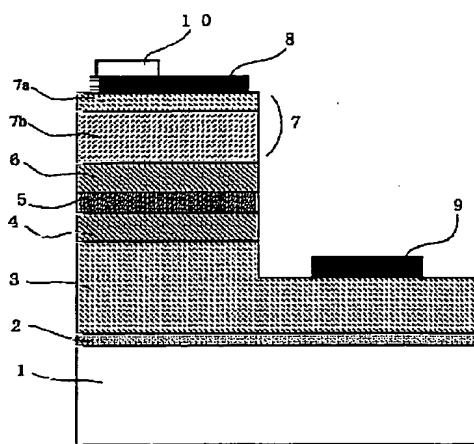
【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の一実施の形態であるLEDの模式的断面図である。

【符号の説明】

- 1 … 基板
- 2 … バッファ層
- 3 … n型コンタクト層
- 4 … n型クラッド層
- 5 … 活性層
- 6 … p型クラッド層
- 7 … p型コンタクト層
- 7a … 第2のp型コンタクト層
- 7b … 第1のp型コンタクト層
- 8 … p電極
- 9 … n電極
- 10 … パッド電極

【図1】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.